This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-005392

(43)Date of publication of application: 10.01.1990

(51)Int.CI.

HO5B 3/84 H05B 3/20

H05B 3/86

(21)Application number: 63-293730

(71)Applicant : PHILIPS GLOEILAMPENFAB:NV

(22)Date of filing:

22.11.1988

(72)Inventor:

BAUDRY HUGHES MONNERAYE MARC MORHAIM CLAUDE

(30)Priority

Priority number: 87 8716255

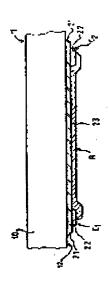
Priority date: 24.11.1987

Priority country: FR

(54) GLASS-CERAMIC HEATING ELEMENT AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To exhibit excellent performance by depositing screen printing layers on a lower face, wherein each of the layers is formed of a specific insulating material, conductive material and dielectric material. CONSTITUTION: An insulating layer 21, a conductive material 22 serving as a current supplying line and a dielectric resistant layer 23 are deposited on the lower face 12 of a glass-ceramic plate supporter 10. The insulating layer 21 is prepared by treating a predetermined quantity of a starting mixture in a glass or amorphous phase; the conductive material 22 is made of Ag or CuO; and the resistant layer 23 is prepared by treating a predetermined quantity of a starting mixture in a glass or active phase. Each of the layers 21, 22, 23 has an expansion coefficient approximate to that of a glass-ceramic material, and heating at about 650° C can be achieved by thermal dissipation. A heating member R is heated by power supply lines C1, C2 of the conductive material 22, and the insulating layer 21 can form an insulator even if temperature becomes high. Furthermore, the dielectric layer 23 can uniformly distribute heat over the entire heat source surface, thereby enhancing performance of an element.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

⑬日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

□ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-5392

®Int. Cl. 3

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)1月10日

H 05 B

3/84 3/20 3/86

3 9 3

7719-3K

7719-3K H 05 B 3/20

392

審査請求 未請求 請求項の数 12 (全9頁)

69発明の名称

ガラスーセラミツク加熱素子

卸特 顧 昭63-293730

@出 願 昭63(1988)11月22日

優先権主張

図1987年11月24日図フランス(FR)図8716255

⑫発 明 者 ユーグ・ボドリー

フランス国 91480 パレン・ジヤルシー シユマンド

ヴィルムヌー13

切発 明 者 マルク・モヌレー

フランス国 94100 サン-モール-デ-フォス アプニ

ユ アンリ マルタン 80テル

個発 明 者

クロード・モルエ

フランス国 75014 パリ リユ レーモン ロスラン146

⑩出 願 人 エヌ・ベー・フイリツ

オランダ国5621 ベーアー アインドーフエン フルーネ

パウツウエツハ 1

プス・フルーイランペ ンフアプリケン

砂代 理 人 弁理士 杉村 晓秀

外1名

明 楜 青

- 1. 発明の名称 ガラスーセラミック加熱選子
- 2. 特許請求の範囲

- 全熱顔面にわたって熱を均一に分布させう るような設計の回路の形で、線C₁とC₂の間に 配置した加熱抵抗体 R を構成する誘電体材料 の第 3 層23 により形成することを特徴とする ガラスーセラミック加熱素子。

- 2. 層21が熱源の面を基礎板から完全に絶縁し、 導電層22を互いに絶縁され、熱源の周囲の両 例に配置された二つの条片C₁及びC₂として設 け、抵抗層23を線C₁から線C₂に延在し、互い に間隔を置いて位置し、かつ熱源の全表面を 加熱するように分布させた請求項1記載の加 熱素子。
- 3. 導電層22の条片が線状であり、抵抗層23の 条片が線状で平行であり、熱源が正方形又は 長方形形状である請求項2記載の加熱素子。
- 4. 導電層22の条片が円弧であり、抵抗層23の 条片が円弧であり、熱源が円形又は楕円形に 近い形状を有する請求項2記載の加熱素子。
- 5. 出発混合物が次のモル比の酸化物:

ZaO + MeO

50~65%

B 2 O 2

10~20%

A1.0.

0~10%

SiO,

40~50%

(式NeO は、MgO, CaO のような耐火性酸化物から選ばれた酸化物である。)

で構成されるガラス相を有し、MeO は2nO + MeO 比が前記ガラス相の50~65 モル%を構成するように2nO と関連してガラス相全体のにル比 0~10%を占め、かつ出発混合物が無定形 相と関連してがラス相が無定形相と関連してがラス相が無定形相と関連して3~13 容量%、無定形相として37~87 容量%を占める請求項1ないし請求項4のいずれか一つの項に記載の加納素子の暦21の形成に適する絶縁ペースト用出発混合物。

6. ガラス相が次のモル比の酸化物:

ZnO + MeD

62 %

SiO.

21 %

B. O.

1796

から構成される請求項 5 記載の出発混合物。

7. ガラス相が次のモル比の酸化物:

2n0 + Me8

62 %

强混合物。

- 11. 出発混合物が銀粉末(Ag)とバラジウム(Pd) 又は白金(Pt)のそれぞれ80~100 %及び20~ 0 %の容量比で形成された、請求項1ないし 請求項4のいずれか一つの項に配載の加熱素 子用熱源の導電層22を得るのに適した導電 性ペースト用出発混合物。
- 12. 少なくとも次の段階:
 - a) 請求項5ないし請求項8のいずれか一つの項に記載の出発混合物を、スクリーン印制ペーストの重量の10~40%比のレオロジー減質、例えばテルピネオール混合物に混入してつくった抵抗ペーストによって絶縁層21に対して選んだ形状に従ってスクリーン印刷によって絶縁層21を堆積させること、
 - b) この層をコンペヤー炉の中で空気中約 900 での温度で約10分間焼成すること、
 - c) 請求項10又は請求項11に記載の出発混合物をスクリーン印刷ペーストの重量の10~40%の比の、テルビネオール混合物のよう

SiO₂ 21% 0₂O₃ 12%

Al.O. 596

から構成される請求項5記載の出発混合物。

- 8. 全混合物に対してかラス相が5容量%の比で無定形相が95容量%の比である請求項5ないし請求項7のいずれか一つの項に配載の出発混合物。
- 9. 出発混合物が全混合物に対し容量比でRuO 2 15~40%、CuO 0~5%で構成される活性相と、ガラスーセラミックの組成と同様な組成で幾りの容量比で形成されるガラス相とを有する請求項1ないし請求項4のいずれか一つの項に記載の熱源の抵抗層23を得るのに適した抵抗ペースト用出発混合物。
- 10. 出発混合物が銀粉末(Ag)と酸化鋼(Cu0) の それぞれ80~100 %及び20~0%の容量比で 形成された、糖求項!ないし請求項4のいず れか一つの項に記載の加熱素子用熱源の導電 層22を得るのに適した導電性ペースト用出

なレオロジー鉄質に混入してつくった導電性ペーストを用いて電流供給線C,及びC。を 形成するように遅んだ形状に従ってスクリ ーン印刷によって導電暦22を堆積させるこ

- d) この層をコンペヤー炉の中で空気中約 900 での温度で約10分間焼成すること、
- e) スクリーン印刷ペーストの全重量の10~ 10%の比の、テルビネオール混合物のようなレオロジー媒質に請求項 9 記載の出発混合物を混入してつくった抵抗ペーストを用いて加熱抵抗体 R を形成するように 選んだ形状に従ってスクリーン印刷によって抵抗層23を堆積させること、
- f) この層をコンペヤー炉の中で空気中約 900 セの温度で約10分間焼成することより なる請求項[ないし請求項4のいずれかー つの項に記載の加熱素子の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

この発明は、ガラスーセラミック板上に設けた

平らな電気加熱部材を少なくともそなえるガラス ーセラミック加熱素子に関する。

この発明は、維持が容易で550 で以上の高温で 動作する熱源に用いるガラスーセラミック板が必 要な変度用質を提供するのに用いられる。

では、 で気にない。 で気にない。 で気にない。 で気にない。 で気にない。 で気にない。 でないではない。 ではない。 ではないがががられる。 ではない。 ではない。 ではない。 ではないがががられる。 ではない。 ではない。 ではない。 ではないがががられる。 ではない。 ではない。 ではない。 ではないがががられる。 ではない。 ではない。 ではない。 ではない。 ではないがががられる。 ではない。 型の電気こんろの使用を、例えば調節可能な焰をで 有する観理器具より柔軟性でなくする。

この発明の目的は、この形の不利益点 9 有しない加熱素子を提供することである。

このように設計する場合、この発明は、前記間

題に加えて若干の他の問題を解決する。実際、技術の現状では、セラミック(Al₂O₃) 基板上にスクリーン印刷により製造され、約150 七の程度の温度に到達しうる抵抗体が既に知られている。これらの温度は、650 七程度の温度が必要である調理目的用電気こんろを提供するには絶対に不十分である。

この発明は、この問題を耐高温ペースト用析規配合を提供することにより解決する。しかし、またこのペーストの膨張係数が調理温度において、又は動作温度において、できるだけガラスーセラミック基板の膨張係数(これはほとんどゼロである。)に近いことも必要である。これは、伝導性粒子を含有する抵抗材料にとって実現が困難である。しかし、この発明は、この問題を解決する。

この発明は、現在まで業界で全く知られていな かった問題を提起し、かつ同時に解決する。

すなわち、電気抵抗体をガラスーセラミック材料上にスクリーン印刷し、次いで電流を供給して 熱伝達による加熱素子を提供した場合、電気こん

しかし、この発明は、このような高温でのガラスーセラミック支持体に十分整合して適合する膨 張係数を有する、高温での電気的絶縁層用の配合 を提供することによりこの問題を解決する。

従来技術からスクリーン印刷ペーストを提供するためにガラス層とセラミック層のコンパウンド を通常用いることが知られている。絶縁層を形成

したがって、抵抗体は高温で完全に絶縁され、 その温度係数は正であり、全デバイスはエージン グ過程に十分耐える。この発明とその作用は、添 付図面を参照して次の説明からいっそうよく理解 されるであろう。

て、加熱素子が加熱すべき表面から若干距離を置いて存在する場合、かなりの温度勾配が空気中につくられるという不利益点を有する。この点に、がラスーセラミック板と直接接続して熱抵抗を減少させる熱調を電気こんろに実現することを可能にするこの発明の利点が存する。

ガラスーセラミック材料の熱伝導率が劣ること は、電気こんろ間に各電気こんろの外部で、熱く なく、任意に電気接点を伝統的な、したがって安 価なはんだ付け材料を用いて設けることができる 領域を保つ利点として用いられる。

この発明に従って、版のがラスーセラミック材料における、300 でより高い温度では無視し得ない電気伝導現象の発生を防止するために絶縁層21を最初に関12上に直接堆積させる。この材料は、第一に板10の膨張係数に、より高くなった層23の膨張係数を有する型である。また、この材料は、監係数を有する型である。また、この材料は、型のものでもある。最後にこの材料は、抵抗層23に

第1 図の断面図に示すように、この発明に従う ガラスーセラミック加熱素子は、上面11 が作用部 として役立つガラスーセラミック板支持体10 及び その下面12上に設けた加熱素子用基板20をそなえ る。

このような加熱会子は、極めて滑らかな作用部、 したがって調理なべからの固体又は液体食物粒子 が、例えば、とどまりうる溝がないので、清浄化 が容易な作用部をそなえるという利点を有する。 この滑らかで平らな面は、調理なべを極めて安定 した仕方で作用部上に保ち、これにより良好な熱 交換を可能にするので、有利である。

ガラスーセラミック板の下面12は、第2図に平面図で示す型の加熱素子により構成される少なくとも熱源によりおおわれる。

現在まで、ガラスーセラミック材料は、美的理由、前記実用特性及びなかんずく耐熱衝撃性を振めて大きくするゼロの膨張係数を有するという事実によって電気こんろ用に遅ばれた。他方、この材料は、むしろ劣った熱伝導体であり、したがっ

拡散せず、調理温度でも、高温でも拡散しない型 のものであり、かくしてエージング中抵抗層の温 度係数(TC) の変化を防止する。

第5a 図の曲線C、は、絶縁材21の相対的線形変化 Δ1/1 を温度Tの関数として示し、第5b 図の曲線C、は、同じ温度におけるガラスーセラミック材料10の対応する変化を示す。これら二曲線は、両方共0に極めて近い。

第2図に示すように、絶縁材21は、電気こんろの熱源を構成する帯域の全面に堆積される。

第2図のそれぞれ【一!軸及び【一 I 軸断面略 図である第3図及び第4図は、絶縁圏21が100μm 以上の厚さの均一層であることを示す。

加熱素子に電流を供給する電流供給線C:及びC。 は、印加電圧及び所望温度によるが、約50 μm の 厚さの層として絶縁層21の表面上に堆積されたス クリーン印刷条片の形でつくられる。これらの線 は、導電性コンパウンド22でつくられる。

抵抗コンパウンド23でつくられ、約10~50 μα の厚さのスクリーン印刷層として堆積された条片 Rが個21の表面上、電流供給級22の間に延在する。 個23を構成する抵抗材料は、高温でガラスーセラ ミック材料の膨張係数にできるだけ近い膨張係数 を有するものである。

第2図は、これらの抵抗条片Rを電力供給線の間に堆積させた2枚の有利な図面を示す。これらの図面は、この発明に従う加熱素子を無差別に使うことができ、この型の回路に対して絶対的にすべての型の構造を提供することができることを理解させるために、例として示しただけである。

しかし、回路の動作寿命の改良のために抵抗条 片の製造において鋭角を有する路の使用をできる だけ登けることが有利である。

回路は、このようにして第2b図に示すような正方形帯域、長方形、楕円形又は第2a図に示すような円形帯域を形成して電気こんろをおおう。 更に、消費者、すなわち顧客の希望に従って異なる形状の若干の電気こんろをそなえる調理場を提供することが望ましい。更に、現在市販されている二つの複単径の表面だけでなく、任意所望の表面複の

このレイアウトは、必須ではなくて、線C,及びC,の端部と、加熱抵抗体Rのための供給電流を導くための導体との間のはんだ接続を設けるのが有利である。実際、層22は、直接ガラスーセラミック材料に設けられる場合、いっそうしっかりと固定され、いっそう良好な機械抵抗を有する。これは、上記型の接続を実現することを可能にする。

この発明に従って、暦21.22 及び23は、以下に述べる配合のコンパウンドを用いるスクリーン印刷技術を用いてつくられる。

運気こんろを実現することができる。

この発明に従う回路がガラスーセラミック調理 域の下面12に設けられるので、作用域として役立 つ上面11には何もない。

この発明に従う加熱素子の別の利用として、浸 液ヒーターとして使用するため別に回路をガラス ーセラミック支持体上に小さい寸法で形成するこ とができる: 例えば液体を迅速に所定温度に加熱 するのに使われる。液体中での電流損失を避ける ために、回路を層21と類似の上部絶縁層でおおう ことができる。

浸漬ヒーター素子におけるこの使用のために、 浸漬ヒーターの任意の型のように供給端子にも不 途波の絶縁スリーブを設けることができる。

また、他の適用において、この発明に従う加熱 素子を熱空気対策炉又は熱風循環炉又はマイクロ 被オーブン中の頂部又は底部加熱板(底又は天井) を実現するにも用いることができる。

導体のろう付け接続を電気こんろの加熱域から 離すように、線C₁及びC₂は、それらの端部が比較

高温絶縁スクリーン印刷ペーストがつくられ、 重楽中で焼成される絶縁組成物用の出発混合物は、 欧州特許 0 0 1 6 4 9 8 号明細書に開示された従 来技術から知られ、該明細書に前記混合物が次の モル比の酸化物:

\$i0 ₂	30~55%
ZnO	20~40%
B ₂ O ₂	0 ~20%
Al ₂ O,	0~10%
SrO, BaO, CaO	5 ~40%
C 0 0	0 ~ 10 %

により構成されるがラス相と、2n0 +Co0 により 構成されるセラミック相とを有し、混合物容量中 ガラス相が85~60%、セラミック相が15~40%を 占めることが記載されている。

しかし、この混合物は、高温においてアルミニウムの膨張係数に近い、すなわちがラスーセラミック材料自体のそれとは極めて違い膨張係数を有する。

このため、この発明に従って、層21に好適な、

特別平2-5392(6)

すなわち、高温で絶縁性があり、同時にガラスーセラミック材料に近い膨張保数を有し、しかもより高くなった抵抗層に拡散しないスクリーン印刷ペースト用出発混合物は、まず次のモル比の酸化物:

2n0 + KeO

50~65%

8.0.

10~20%

AlaOs

0~10%

SiO.

40~50%

(式NeC) は、NgO, CaO のような耐火往酸化物から選ばれた酸化物である。)

で構成されるガラス相を有し、MeO はZnO + MeO 比が前記ガラス相の50~65モル%を構成するようにZnO と関連してガラス相全体のモル比 0~10%を占める。

-例において、次のモル比の酸化物:

ZnO + MeO

62%

0.0.

1796

SiOz

21%

から構成されるガラス相が見られる。

ミル粉砕は、液体剤、例えば水、の中で行うことができる。次いで、ミル作業生成物を乾燥し、 有機謀質中に分散させる。

この出発混合物をスクリーン印刷に適するようにする適当な有機嫉質として、重合体含有溶液、例えばテルビネオール又はテルビネオール基質混合物中のエチルセルロース溶液を用いることができる。この有機媒質は、焼成前、スクリーン印刷ペーストの重量の10~40%を占めることができる。ペーストに対する有機媒質の比は、所望のレオロジー特性の関数として選ばれる。

この場合、ガラスーセラミック上の加熱デバイス用に選ばれた材料は、どれも空気中で酸化が起こる危険がないので、ペーストの協成は、開放空気中で行われる。したがって、有機媒質は、空気中の酸素の助けにより消費される。約900 でにおける焼成作業が約10分間コンペヤー炉中で行われる。

他方、欧州特許第0048063号明細書は、 ±10010-10-10-10の程度の抵抗の温度係数を有する 別の例において、次のモル比の酸化物:

Zn0 + Xe0

62 %

8.0,

12%

A1-0.

5 %

SiO₂

21%

から構成されるガラス相が見られる。

このような絶縁コンパウンド用の出発混合物は、 更に無定形相を有する。ガラス相と無定形相は、 次のような容量比で関係する:

ガラス相 3~13%、好ましくは5% 無定形相97~87%、好ましくは95%

この発明に従って、無定形相は、低膨張係数のため退ばれた無定形二酸化ケイ素により構成される。

この発明に従う絶縁スクリーン印刷ベーストを 適当に実現するために、前記組成物又は示した例 の一つに相当するモル比のガラスを最初につくっ た。このようにして得られたガラスをミルにかけ る。このミル作業中に無定形相を形成する粉末を 遅ばれた容量比で混合して均一な混合物とする。

抵抗コンパウンド用の出発混合物を開示する。このコンパウンドは、二個及び/又は三価金属の六本ウ化物と、ホウ酸カルシウム及び、恐らく、二酸化ケイ素よりなるガラスフリットとの混合物により形成される活性相よりなる。

しかし、この低抗ペーストにおいて、ガラス組成物は、その目的が加熱低抗体、いっそう詳細にはジュール効果によって650 でに上げることができ、しかも何年にもわたって保持される正の温度係数の抵抗を有する加熱抵抗体ではない。

したがって、この発明に従って、この特性とが ラスーセラミック材料に近い膨張係数とを有する 着23の実現に好適なスクリーン印刷ペースト用出 発混合物は、まず第一に全混合物に対し次の容量 比の化合物:

RuO. 15 ~40%、好ましくは≈30%

CuO 0 ~5 %

で構成される活性相と、溶融硬化ガラスーセラミックの組成と同様な組成を有し、上記混合物に諸 足的な容量比のガラス相とを有する。したがって、 賢明な無サイクルによって、結合剤として作用するがラス甚質は、その後、同じサイクル中にガラスーセラミックに再結晶する。このようにしてつくられたガラスーセラミックは、適当な膨張係数を付与することを可能にする。

他方、この抵抗体の抵抗の温度係数は、適当な 比を与えられた場合、

20 ~30 t +520 ppm t-'
300 ~650 t +150 ppm t-'
である。

抵抗スクリーン印刷ペーストを得るために、ガラス相をミル処理し、活性相を形成する酸化物を 絶縁ペーストの実現の場合の前記仕方で混入する。 この後、混合物を既に述べたレオロジービヒクル 中に浮入する。

この発明に従って、暦22における糠C,及びCzをつくるのに適したスクリーン印刷ペーストは、一例において銀粉末(Ag)プラスパラジウム(Pd)若しくは白金(Pt)で、又は他の例で少量の酸化銅(CuO)を添加した銀粉末(Ag)だけでつくられ、次いでこ

表 I 艳绿厝21用出発混合物

一般組成	(3 ⁵) A	Ø B	
Zn0+xe0 50 ~659	62%	62 %	
sio. 40 ~ 59	21 %	21 %	
8.0. 10 ~209	17 %	1296	
A1.0. 0 ~109	0 %	5 %	
出発混合物	、容量組成 好宝	しい例	
ガラス相 3~1	3% 5	5 %	
無定形相 97~8	196 / 95	95%	

の粉末を前記と同様なレオロジービヒクル中に混 入する。

次の表は、層21,22 及び23用の出発混合物組成を表示する。

表 II 抵抗層23用出発混合物

混合物組成 (容量%)			
		好ましい例	一般組成
ガラス相	がスセラミック 類似組成	≈65 %	100 %の 残り
活性相	ŔuO,	≃30 %	=15~40%
(A) EE. #9	CuO	≃ 5 % -	≃ 0~5 %

表 II 導電用22用出発混合物

混合物組成 (容量%)					
		97) 1			例 2
Ag	80	~100	%	Ag	80~100 %
CuO	20	~0	96	Pd/Pt	20~0 %
				CuO	残り

特閒平2-5392(8)

4. 図面の簡単な説明

第1図は、加熱衆子の断面略図、

第2a図及び第2b図は、この発明に従う電気抵抗 体回路の二つの例の回路平面図、

第3図は、第2図の1~1軸断面略図、

第4図は、第2図のⅡ-Ⅱ輪断面略図、

第5a図は、温度Tと絶縁材の相対的線形変化

△Ⅰ/Ⅰの関係を示すグラフ、

第5b図は、温度Tとガラスーセラミック材料の 相対的線形変化△ l / l の関係を示すグラフである。

10…ガラスーセラミック板支持体

11…上面

12…下面

20 …加热素于用基板

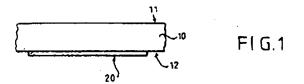
21…絶禄眉

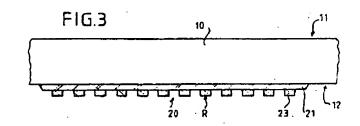
22…電流供給線

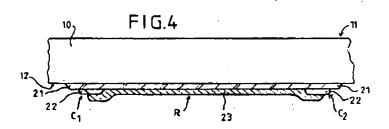
23…抵抗層

C1, C2 … 電流供給線

R …加熱抵抗体







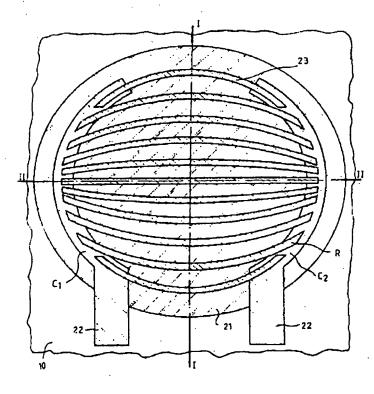
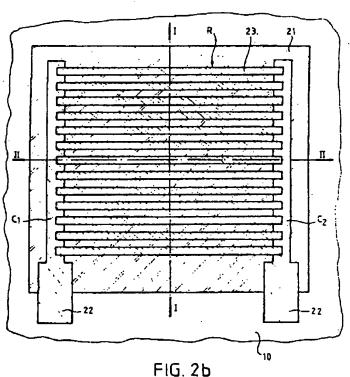


FIG. 2a



-544 -

